

T. G. E. P.

1887

V 432

TlSe (Δ Haq, Δ Hf)

Fabre

Ann. chim. phys., 1887, 10, 532-550

W M

Есть ф. н.

Л. Б. Вч

V 434 1000

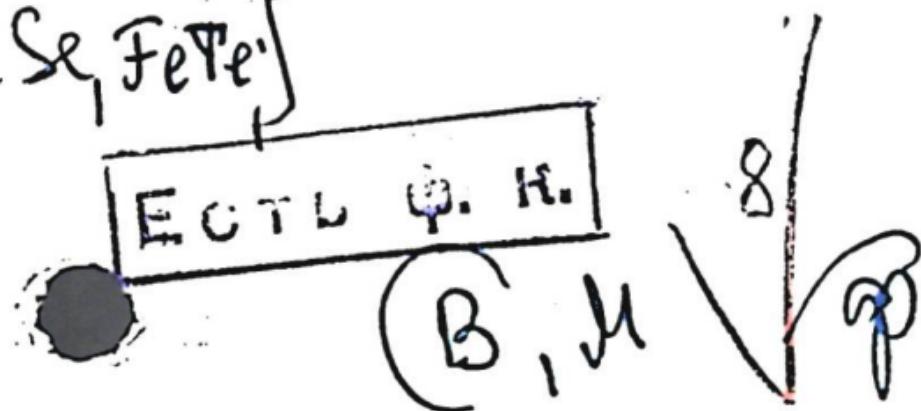
Fabre

2. Ann. chim. phys. 14, 270 (1900)

Tl₂Se; Tl₂Te } (Alf)

ZnSe; ZnTe; AgSe, FeTe

Circ. 500



| | | |
|--------------|---------------|------------|
| Tl_2Se_3 | Bd-9374-IV | 1907 |
| Tl_2Se_5 | Pelaron M. H. | |
| | Compt.-und | 1907, 145, |
| m.g. cb. ba. | 118-21 | |

V 413, 1921

Pelabon

9. Compt. rend. I73, I42 (1921)

Tl₂S, Tl₂Se

Tm

ECTB φ. K.

Circ. 500



5



1960

V 433

TlSe, Tl₂Se, Tl₂Se₃ (P, δHs)

Шахтахтинский М.Г., Кулиев А.А.
Физ.металлов и металловедение, 1960,
9, № 2, 202-204

Исследование упругости насыщенных
паров селенидов таллия

ЕСТЬ Ч. К.

РХ., 1960, 87725

F

Ве, М

BP-V-436

1961

Tl₂Se₃

Sb₂Se₃
P

13Б360. Исследование упругости насыщенных паров некоторых селенидов методом радиоизотопов. Шахтахтинский М. Г., Кулев А. А., Абдуллаев Г. Б. В сб. «Вопр. металлургии и физ. полупроводников». М., АН СССР, 1961, 38—42.—Методом Кнудсена с использованием радиоактивных изотопов Se⁷⁵, Tl²⁰⁴, Sb¹²⁴ измерены в интервалах 450—680° К давления паров: Tl₂Se $\lg p = -5880,9/T + 9,8052$, ΔH (субл.) = 26,905 ккал/моль; TlSe $\lg p = -6742,2/T + 12,443$, ΔH (субл.) = 30,845 ккал/моль; для Tl₂Se₃ $\lg p = -7425,5/T + 9,2481$, ΔH (субл.) = 33,972 ккал/моль; для Sb₂Se₃ $\lg p = -6432,3/T + 8,7906$, ΔH (субл.) = 29,589 ккал/моль. Подробно описана схема прибора, изложена методика проведения исследований.

С. БЫК

+1

x. 1962. 13

B9 - V - 436

1961

Tl₂Se
(Sb₂Se₃)

Equilibrium vapor pressures of some selenides by means of radioisotopes. M. G. Shakhtakhtinskii, A. A. Kuliev, and G. B. Abdullaev. *Vopr. Met. i Fiz. Poluprov., Akad. Nauk SSSR, Tr. 4-go Soveshch., Moscow 1961, 38-42.* The vapor pressures of Tl₂Se, TlSe, Tl₂Se₃, and Sb₂Se₃ were detd. by means of a Knudsen cell from 160° to about 400° by use of radioactive Se⁷⁵, Tl²⁰⁴, and Sb¹²⁴, resp. A vacuum system is described which permits the detn. of pressure at various temps. without the disruption of vacuum. These compds. evaporate as monomers. Above 300° evapn. of Se becomes significant in Tl₂Se. Tl₂Se₃ dissoc. into Tl₂Se + 2Se. The vapor pressures, in mm. Hg, and heats of sublimation, in kcal./mole, resp., are given by: $\log p = -(5880.9/T) + 9.8052$ and 26.905 for Tl₂Se; $\log p = -(6742.2/T) + 12.443$ and 30.845 for TlSe; $\log p = -(7425.5/T) + 9.2481$ and 33.972 for Tl₂Se₃; $\log p = -(6432.3/T) + 8.7906$ and 29.589 for Sb₂Se₃ (T in °K.). I. L. Kalnin

B9P-2100-III

C.A. 1962, 56, 12
13559f.



+1



3712

3342·V

1961

Tl₂Se; TlSe; Tl₂Se₃; Sb₂Se₃ (p)

Шахрахтинский М.Г., Кулиев А.А.,
Абдуллаев Г.Б.

Вопрс. Мет. и Физ. полупров. АН СССР,
Тр. 4-го совещания, Москва, 1961, 29-31

Изучение давления...

Be

Te Se

BP-V-3238

1962

5 Б379. О скорости испарения селенида таллия (Tl_2Se). Генов Л. Х., Несмеянов А. Н., При-
селков Ю. А. «Вестн. Моск. ун-та. Химия», 1962, № 5,
34—35

Давление пара Tl_2Se определено методами Кнудсена и
Ленгмюра. Расчет производился в предположении, что
пары состоят из эквимолярных кол-в Tl_2Se и Tl_2Se_3 .
Скорость испарения с открытой поверхности меньше ско-
рости испарения при эффузии, т. е. коэф. испарения не
равен единице. Приведены эксперим. данные и ур-ние
вида $\lg P = A/T + B$; рассчитано значение $\Delta H =$
 $= 33,56 \text{ ккал/моль.}$

B. C.

X·1964·5

BP - V-3238

1962

The rate of evaporation of thallium selenide. L. Kh. Genov,
A. N. Nesmeyanov, and Yu. A. Priselkov (State Univ. Moscow).

Vestn. Mosk. Univ., Ser. II, Khim. 17, No. 5, 34-5(1962).

The vapor pressure of Tl₂Se was detd. by the methods described earlier (*CA* 56, 13560c). The amt. of condensate was detd. from the radioactivity of Tl²⁰⁴ introduced during the synthesis of the Tl₂Se. The calcns. were carried out under the assumption that the vapor consisted of equimolar amts. of Tl₂Se and Tl₂Se₃.

The vapor pressure was detd. by the effusion method with an effective effusion opening $k\sigma = 7.82 \times 10^{-4}$ cm.²; and by the evapn. method with an open surface of area $S = 1.68$ cm.². The following equations were derived from the exptl. data by the least-squares method: $\log P = 9.9638 - (7384.6/T)$ ($k\sigma = 7.82 \times 10^{-4}$ cm.²), $\Delta H_T = 33.56$ kcal./mole, and $\log P = 11.3501 - (8613.3/T)$ ($S = 1.68$ cm.²), $\Delta H_T = 39.41$ kcal./mole., where P is vapor pressure in mm. Hg and T is abs. temp. The results obtained do not support the work by Shakhtakhtinskii and Kuliev (*CA* 54, 18049h).

E. A. Lizlovs

CA 1963-59-4

33348c

IV У435 1963
Tl₂Se, TlSe, Tl₂Se₃, Tl₂S, Tl₂O,

Sb₂Se₃, KCl, HgSe, HgTe. (P, ρ H_S)

Se, Se₂, Se₆, Se₈ (A.P.)

Шахтакинский М.Г.

Труды института Физ., АН Азерб.ССР,
1963, II, 52-107

Исследование давления насыщенных
и ров различных полупроводников

СА., 1963, 39; N° 4,

3417e.

КНД, М

Есть ф. н.

чп. 67

1963

Tl₂Se_x
Sb₂Se₃

Investigation of the saturated vapor pressure of some selenides with radioisotopes. M. G. Shakhtakhtinskii, A. A. Kuliev, and G. B. Abdullaev. *Vopr. Met. i Fiz. Poluprov., Akad. Nauk SSSR, Tr. 4-go [Chetvertogo] Soveshchaniya, Moscow* 1961, 29-32(Pub. 1963). The vapor pressures of Tl₂Se, TlSe, Tl₂Se₃, and Sb₂Se₃ were detd. These compds. were obtained by the Knudsen method. The results, which are obtained on the assumption that these compds. evap. as monomers, are tabulated from 434 to 687°K. From *Intern. Aerospace Abstr.* 3(21), Abstr. No. A63-23045(1963).

TCHJ

+1

c.a.1964.61.11
126659

Tl₂Se

1965

4 Б677. Термодинамические свойства расплава таллий — селен. Zaleska Ewa, Tęgrilowski Janusz. Własności termodynamiczne roztworów ciekłych tal — selen. «Roczn. chem.», 1965, 39, № 4, 527—532 (польск.; рез. русск., англ.)

Методом измерения э. д. с. концентрационной цепи $Tl|(0,58 \text{ LiCl} + 0,42 \text{ KCl}) + 0,05 \text{ TlCl}|Tl_x - Se_{x-1}$ изучена жидк. система Tl—Se от $N_{Tl}=0,050$ до $V_{Tl}=0,670$ при 400° и для $N_{Tl}=0,050—0,200$ при $390—460^\circ$. Определены хим. потенциалы, парц. мольные энтропии и энталпии, активности и коэф. активностей Tl и Se, а также изменение термодинамич. потенциала, энтропии и энталпии при смешении. Система Tl—Se очень сильно отличается от идеальной. Предполагается, что хим. связь в жидк. системе Tl—Se носит ионный характер, особенно для состава Tl₂Se. Избыточная энтропия смешения до $N_{Tl}=0,430$ положительна, а при $N_{Tl}>0,430$ отрицательна.

Н. Борисов

Бердск
18 - 80

· 4

X. 1966

1969

✓ 6159

TlSe, GaSe (C_p)

Манегов К.К. Керимов И.Г.,
Костюков В.Н., Мехиев М.И.,

Физ. Техн. Материалов.,

1967, 1, №13, 441-442

CA, 1967, 67, #12, 57785x

5

TlSe

1967

2 Е528. Рентгенифрактометрическое исследование теплового расширения кристалла TlSe. Мамедов К. П., Багиров С. Б. «АзэрбССР Елмләр Акад. хәбәрләри. Физ-техн. вәријазијјат елмләри сер., «Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Физ.-техн. и матем. и.», 1967, № 1, 73—76 (рез. азерб.)

тепловое
расшир

см. изб.

оп. 1968. 28

На рентгенидифрактометре УРС-50И исследованы параметры решетки монокристаллов TlSe в интервале т-р 20—100° С. Коэф. линейного расширения α оказались равными вдоль оси a $4,12 \cdot 10^{-5}$ град. $^{-1}$, вдоль оси c $1,16 \cdot 10^{-5}$ град. $^{-1}$ и не зависящими от т-ры. Различие значений α свидетельствует о том, что в направлении c эффективная межатомная связь сильнее, чем в направлении a .

Л. И. Бергер

TlSe

16 Б819. Термодинамические свойства моноселенида таллия. Васильев В. П., Никольская А. В., Бачинская А. Г., Герасимов Я. И. «Докл. АН СССР», 1967, 176, № 6, 1335—1338

Методом э.д.с. с жидк. электролитом изучены электрохим. цепи типа: (—) Tl_mb|KCl+TlCl+глицерин (р-р) |(Tl_xSe_{1-x})_mb (+) (1) для девяти сплавов таллия с селеном (5,0; 32,5; 39,0; 40,6; 42,1; 44,8; 45,5; 48,5; 49,5 ат.% Tl) в интервале т-р 40—140°. На основании эксперим. значений $E=f(T)$ и рентгенофазового анализа сплавов показано, что все сплавы представляют собой смесь двух фаз Se+TlSe. Потенциалобразующему процессу цепи (1) в таком случае соответствует р-ция $\alpha = \text{Tl} + \text{Se(гекс.)} = \text{TlSe(mb.)}$ (1). Эксперим. результаты

ΔH_m ,

ΔH_f

д. 1968. 16

B90 - 58992 - 1

1964

зависимости э. д. с. от т-ры для всех изученных сплавов представлены в виде ур-ния: $E(b) = \{(0,6319 \pm 0,0055) - (3,0 \pm 1,5) \cdot 10^{-5} T\} \pm 0,0056$ (2). На основании ур-ния (2) и известных термодинамич. соотношений рассчитаны изобарно-изотермич. потенциал (ΔG), энタルпия (ΔH) и энтропия (ΔS) образования моноселенида таллия для р-ции (1). В расчетах по ур-нию $\Delta G = -zFE$ валентность иона таллия принималась равной 1. ΔG_{298}° к = $-14,39 \pm 0,13$ ккал/моль; $\Delta H = -14,57 \pm 0,12$ ккал/моль; $\Delta S = -0,69 \pm 0,34$ энтр. ед. Вычисленная теплота плавления для моноселенида таллия по ур-нию L (пл., TlSe) = $= \Delta H$ (обр. жидк, TlSe) $- \Delta H$ (обр., тв., TlSe) $+ L$ (пл., Tl) $+ L$ (пл., Se) составляет 4,7 ккал/моль. Автореферат

1987

33794u The thermodynamic properties of thallium monoselenide. V. P. Vasil'ev, A. V. Nikol'skaya, A. G. Bachinskaya, and Ya. I. Gerasimov (Mosk. Gos. Univ. im. Lomonosova, Moscow). *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 176(6), 1335-8(1967)(Russ). The emf. of the cell (-)Tl(s)|glycerol, KCl, TlCl|Tl_xSe_{1-x}(s)(+) was measured at 40-140° and for $x = 0.05-0.495$. The emf. values fall along a straight line when plotted vs. temp. for all x measured. Only the Tl and TlSe phases were observed. The Gibbs free energy change ΔG for the reaction $\alpha\text{-Tl}(s) + \text{Se}$ (hexagonal) = TlSe(s) was calcd. from emf. values as $\Delta G = (-14.572 \pm 0.127) + (0.692 \pm 0.346) \times 10^{-3}T$ kcal./mole. The heat of fusion of TlSe was detd. as 4.7 kcal./mole. Karel A. Hlavaty

Hse

T-g cl. 6e

DO

C 1
1
1
B9P-5892-1

C.A

1988-68-8

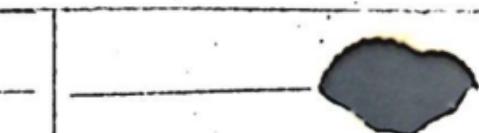
ВФ - 6536-*V*

1968

Tl₂Se₃
 15 Б879. Электрохимическое исследование системы таллий — селен в твердом состоянии. Tęgr i Ł o w s k i Janusz, Zaleska Ewa, Gaweł Wiesław. Badnia elektrochemiczne stopów stałych tal=selen. «Roczn. chem.», 1968, 42, № 11, 1845—1848 (польск.; рез. русск., англ.)

Tl Se
 Определялась при 160° э. д. с. элементов: —Tl⁺ (тв. электрод сравнения) | NaCl+TlCl (р-р солей в глицерине) | Tl_x—Se_{1-x} (тв. электрод из сплава) +0,100 < x < 0,900. Установлено существование двухфазных областей Se+Tl_xSe₃ (I), 1+TlSe (II) и Tl₂Se (III)+α-Tl. Исключена возможность существования области II+III. Выявлена возможность образования новой фазы Tl₅Se (IV). Термодинамич. потенциалы образования I, II, IV и III из тв. Tl и Se при 160°, соотв. равны $-27,82 \pm 0,18$, $-13,51 \pm 0,09$, $-59,44 \pm 0,46$ и $-22,58 \pm 0,19$ ккал/моль.

Б. Я. Каплан



ВФ - 2 - 6536

2 · 1969

· 15

1968

B9P - 6536-✓

Tl₂Se

3

100338e) Electrochemical investigations of thallium-selenium solid systems. Terpilowski, Janusz; Zaleska, Ewa; Gawel, Wieslaw (Akad. Med., Wroclaw, Poland). *Roczn. Chem.* 1968, 42(11), 1845-8 (Pol). Thermodynamic properties and the phase equil. of the system Tl-Se were studied by emf. measurements with concn. cells of the type: (-)Tl | solid reference electrode | NaCl + TlCl (soln. of salts in glycerol) | Tl_xSe_{1-x} (solid alloy electrode) (+). Solid alloys contg. 0.100-0.900 atom fractions of Tl were investigated at 160°. From the relation between emf. and Tl concn. in alloys, the formation of Tl₂Se₃ (I), TlSe (II), Tl₂Se (III), and presumably Tl₅Se₃ (IV) was inferred. The values of the Gibbs function of formation of I, II, III, and IV from the solid elements at 160° are -27.82 ± 0.18 , -13.51 ± 0.09 , -22.58 ± 0.19 , and -59.44 ± 0.46 kcal./mole, resp.

Ewa Bartel-Kornacka

Δy 0
4

C.A. 1969

40-22

1969

Tl₂Se
2

7 Б855. Термодинамические свойства низшего селенида таллия (Tl₂Se). Васильев В. П., Никольская А. В., Герасимов Я. И. «Докл. АН СССР», 1969, 188, № 6, 1318—1320

Tl₂Se

Tl₂Se₃

Герасимов
св-68

Измерены э. д. с. цепей (—) Tl_m (глицерин+KCl+TlCl) (Tl_xSe_{1-x})_m (+) (x — мольная доля таллия в сплаве, $x=0,510—0,715$) в интервале 40—80°. Рассчитаны стандартные значения энергии Гиббса, энталпии (ккал/моль) и энтропии (э. л.) образования фазы Tl₂Se: ΔG° (обр., 298) = $-22,80 \pm 0,06$, ΔH° (обр., 298) = $-22,12 \pm 0,27$ и ΔS° (обр. 298) = $+2,27 \pm 0,72$. Для соединения Tl₂Se обнаружена область гомогенности шириной около 4 ат. % в сторону Se. Ход изменения парц. энтропии образования в этой области дает основание предположить в ней упорядочение дефектов.

Автореферат

X. 1970. 7

1969

TlSeTl₂SeΔGΔHΔS

104657x Thermodynamic properties of the lower selenide of thallium (Tl_2Se). Vasil'ev, V. P.; Nikol'skaya, A. V.; Gerasimov, Ya. I. (Mosk. Gos. Univ. im. Lomonosova, Moscow, USSR). *Dokl. Akad. Nauk SSSR* 1969, 188(6), 1318-20 [Phys.-Chem.] (Russ). The emf. (E) was measured for elements with Tl-Se alloys contg. 51.0-71.5 atom % Tl. The results were used to plot the phase diagram for the solid state Tl-Se system in the Tl-rich region (>50 atom %); the diagram has 2 heterogeneous regions ($\text{TlSe}-\gamma$ -phase (62.5-63.1 atom % Tl) and γ -phase ($\text{Tl}_2\text{Se}-\text{Tl}$) and one homogeneous region (γ -phase). The equations for $E = f(T)$ and known thermodynamic relations were used to calc. the change in the partial values of the Gibbs energy (ΔG_{Tl}), the enthalpy (ΔH_{Tl}), and entropy (ΔS_{Tl}). The results are tabulated along with literature data for TlSe and Tl_2Se .

GLJR

C.A. 1970 72-20

TeSe
= -

Масеев К.К. 1970
и гр.

Gp,
S, H-H

B сб. "Перспективы и"
перспективы конституций
и., "Наука", 217.

(BGP - 55-XV)

● (лн. GaSe) I

TeSe

Bsp-231-XV

1971

20 Б581. Исследование термодинамических свойств селенида таллия. Агдамский Т. А., Мамедов К. Н., Аббасов А. С. «Елми әсәрләр. Азәрб. унив. Кимја елмләри сер. Уч. зап. Азерб. ун-т. Сер. хим. и.», 1971, 11—13.

Впервые методом э. д. с. изучены термодинамич. функции образования моноселенида таллия (свободная энергия, энтальпия и энтропия). На основании результатов исследования проведен анализ с целью уточнения диаграммы состояния системы таллий — селен (область Se—TlSe).

Резюме

X. 1971. 20

TlSe

B99 - 231-XV

1841

80261p Thermodynamic properties of thallium selenide.
Agdamskii, T. A.; Mamedov, K. N.; Abbasov, A. S. (USSR).
Uch. Zap. Azerb. Univ. Ser. Khim. Nauk 1971, 11-13 (Russ).
From Ref. *Zh., Khim.* 1971, Abstr. No. 20B581. Thermodynamic functions (free energy, enthalpy, and entropy) of TlSe were detd. by an emf. method. A phase diagram of the Tl-Se system (Se-TlSe region) is presented.

(ΔG, ΔH)

(ΔS[°])

C.A. 1842. 47. 12

Tl₂Se

1971

6 Б753. Энталпии смешения в жидким состояниии.
II. Tl+Se и Tl+S. Maekawa Takashi, Yokokawa Toshio, Niwa Kichizo. Enthalpies of mixing in the liquid state II. Tl+Se and Tl+S. «J. Chem. Thermodyn.», 1971, 3, № 5, 707—710 (англ.)

При т-рах 631 и 753° К описанным ранее методом (см. сообщ. I, РЖХим, 1971, 16Б753) измерены энталпии смешения H^E жидк. талмия с селеном и талмия с серой. Обнаружено, что минимумы на кривых зависимости H^E от мол. доли Tl соответствуют составу Tl₂Se и Tl₂S. Изученные системы сходны с системой Tl—Te.

П. М. Чукров

(+1)

Ржчд, 1972, ~ 6

Tl + Se

1971

Tl + S

(ΔH)

18690d) Enthalpies of mixing in the liquid state. II. Thallium + selenium and thallium + sulfur. Maekawa, Takashi; Yokokawa, Toshio; Niwa, Kichizō (Fac. Sci., Hokkaido Univ., Sapporo, Japan). *J. Chem. Thermodyn.* 1971, 3(5), 707-10 (Eng). Enthalpies of mixing of Tl + Se and Tl + S in the liq. state were measured. Both systems showed behavior similar to that of Tl + Te.



C.A. 1972.06.14

TlSe

1971.

Kerimov, I.G., et al.

Teplofiz. Svoistva Tverd.

Tel, Mater. Vses. Teplofiz.

Konfer. Svoistva Veshestv

Vys. Temp. 3rd, 1968, (pub. 1971,)
202-10, Russ.

Cp ;

S°₂₉₈-S°₀

H°₂₉₈-H°₀

(crys. GaS; T)

TlSe

БФ - 380 - XV

1971

Tl_xSe

2 Б752. Термодинамическое исследование сплавов системы таллий — селен методом электродвижущих сил.

Васильев В. П., Никольская А. В., Герасимов Я. И. «Ж. физ. химии», 1971, 45, № 8, 2061—2063

Измерены э. д. с. цепей (—) $\alpha\text{-Tl}_{\text{тв}}|\text{глицерин}+\text{KCl}+\text{+TlCl}|(\text{Tl}_x\text{Se}_{1-x})_{\text{тв}}$ (+), содержащих сплавы Tl с Se с мол. долей Tl от 0,050 до 0,715, в т-рном интервале 40—180°. На основании эксперим. данных рассчитаны стандартные значения энергии Гиббса, энталпии и энтропии образования, равные для TlSe и Tl_2Se при 298° К соотв. $-14,37 \pm 0,02$ ккал/моль, $-14,57 \pm 0,12$ ккал/моль; $-0,69 \pm 0,34$ э. е. и $-22,80 \pm 0,06$; $-22,12 \pm 0,27$ и $+22,7 \pm 0,72$. Предложены нек-рые изменения фазовой диаграммы системы Tl — Se в т-рном интервале 20—190°. Эти изменения касаются области составов 62,5—66,7 ат. % Tl, где обнаружена фаза переменного состава (γ -фаза), а также области 0—50 ат. % Tl, где показано отсутствие фазы Tl_2Se_3 .

Автореферат

X. 1972. 2

Tl + Se, Maekawa Takashi; et al. 1972

(ΔH_{mix}) "J. Chem. Thermodyn." 1972,
4, n6, 873-8.

● (crys. Bi + Se, I)

TlSe

октябрь 1790
ХV-1465

1973

6 Е1004. Термоемкость моноселенида таллия от 3 до 600° К. Втеков Г., Meissner M., Scheiba M., Tausend A., Wobig D. Specific heat of thallium monoselenide between 3 and 600° K. «J. Phys. C: Solid State Phys.», 1973, 6, № 24, L462—L464 (англ.)

(Cp)

Термоемкость малых монокристаллов TlSe изучена импульсным методом в области т-р 3—300° К и дифференциальным калориметрическим методом в области 190—600° К. Приведена таблица сглаженных значений теплоемкости. Т-ра Дебая найдена равной ~110° К.

ф. 1974 № 6

оттиски 1790

1973

TlSe

13 Б672. Теплоемкость моноселенида таллия между 3 и 600° К. Влеков Г., Мейсснер М., Scheiba M., Tausend A., Wobig D. Specific heat of thallium monoselenide between 3 and 600° K. «J. Phys. C: Solid State Phys.», 1973, 6, № 24, L462—L464 (англ.)

(C_p)

Теплоемкость TlSe измерена двумя методами в интервалах т-р 3—300° К (импульсный нагрев) и 190—600° К (дифференциальная калориметрия). Результаты, полученные разными методами, хорошо согласуются между собой и с данными др. авторов. Отмечена большая величина теплоемк. при низких т-рах, являющаяся следствием низкой т-ры Дебая ($0 \approx 110$ ° К). Кубич. зависимость теплоемк. от т-ры нарушается уже при т-ре около 3° К. При т-ре $T > 0$ зависимость теплоемк. от т-ры существенно ослабляется. С. Ш. Шильштейн

Х. 1974. № 13

XV-14/65

TlSe

ommunen 1790
XV-1465

1973

(C_p)

64456n Specific heat of thallium monoselenide between 3 and 600°K. Brekow, G.; Mueissner, M.; Schieiba, M.; Tausend, A.; Wobig, D. (II. Phys. Inst., Tech. Univ. Berlin, Berlin, Ger.). *J. Phys. C* 1973, 6(24), L462-L464 (Eng). The sp. heat at const. pressure of small single crystals of TlSe was measured by applying a heat pulse technique in the temp. range 3-300°K and a differential calorimetric measuring method in the temp. range 100-600°K.

C.A. 1974. 80. w12

Pl. 2

Orlov, Yu. F.;

1973

Kurchevskaya, E. O.;
Fedorova, G. A.

(P)

Zh. Prikl. Khim. (Leningrad),
1973, 46(4), 745-8.

(an As_xSe_3 , I)

Tl_2Se Kabré S., 1974
Julien-Pouzol et al.
"Bull. Soc. chim. France"
 $T_m.$ 1974, no 9-10, 1 part;
1881-1884, X (pp.)

(cu Tl_2S ; I)

x. 1975. N7

Tl₂Se (mb)

Issue of Tasmania 1974

Tl₂Se,

Mills K. C.

m.g. cb-ca

288-600

Thermodyn. Data for In-
organic Sulfides, Selenides
and Tellurides. Part III.

London: Butterworths 1974.

Tl₂Se₃

• ap. 639

TESe

Panukkebus Jr. Jr. 1974.
ugp.

Cp; SH; C.S. "Полиграб. u губ."
AS; ♂* J., 1974, 77-83.

● (cav. InSe; I)

* У-10844

1975

Tl₂Se

10 Б865. Теплоемкость Tl₂Se между 3 и 640 К.
Brekow G., Meißner M., Scheiba M., Tausend A., Wobig D. Specific heat of Tl₂Se between 3 and 640 K. «J. Phys. C: Solid State Phys.», 1975, 8, № 21, L456—L460 (англ.)

(C_p)

В калориметре с импульсной подачей тепла в интервале т-р 3—300 К и методом дифференциальной сканирующей калориметрии в интервале 190—640 К измерена теплоемкость Tl₂Se. Выше т-ры 15 К эксперим. значения теплоемкостей находятся в очень хорошем соответствии с ур-нием Тарасова для слоистых структур $C_{2(3)}/9R = D_2(\theta_2/T) + (\theta_3/\theta_2)^2 \cdot [D_3(\theta_3/T) - D_2(\theta_3/T)]$ (1), где D_j — обобщенные функции Дебая, $\theta_2 = 140,3$ К и $\theta_3 = 51,2$ К — характеристич. т-ры для 2- и 3-мерного континуума. При т-рах < 15 К эксперим. данные несколько превышают рассчитанные по ур-нию (1) и соответствуют ур-нию $C_v/9R = 4/5\pi^4(T/\theta_D)^3$, $\theta_D = 100$ К. Табулированы при сглаженных значениях т-р в исследованном интервале величины C_p кал/моль·град, S_t э. е., $(H_t - H_0)$ кал/моль, составившие при 298 К 19,65; 41,77; 4820,3. Найденное значение $S_{298,2}$ согласуется с лит. данными.

Х/1976 N 10

Ж. Василенко

Tl₂Se

* U-10844; XV-3081 1975

(C_P)

84; 50680b Specific heat of thallium selenide (Tl₂Se) between 3° and 640°K. Brekow, G.; Meissner, M.; Scheiba, M.; Tausend, A.; Wobig, D. (Inst. Festkörperphys., Tech. Univ. Berlin, Berlin, Ger.), J. Phys. C 1975, 8(21), L456-L460 (Eng). The specific heat capacity of Tl₂Se [15572-25-5] was measured by applying a heat pulse technique at 3-300°K and differential scanning calorimetry at 190-640°K. The specific heat of the material was described by V. V. Tarasov's equation for a layer structure. Values of thermodn. functions were calcd.

C.A. 1976 84N8

1975

~~Tl_xSe_y~~

9 Б856. Термодинамические свойства и фазовые диаграммы халькогенидов таллия. Васильев В. П., Никольская А. В., Герасимов Я. И. В сб. «Термодинам. свойства метал. сплавов». Баку, «Элм», 1975, 40—46

~~Tl_xTe_y~~

Обобщены результаты собственных исследований термодинамич. св-в халькогенидов таллия методом э. д. с. с расплавленным электролитом. Табулированы и сравниены с имеющимися лит. данными термодинамич. характеристики образования Tl_2S_5 , Tl_8S_{17} , TlS , Tl_4S_3 , Tl_2S , $TlSe$, Tl_2Se , Tl_2Te_3 , $TlTe$, Tl_5Te_3 и Tl_2Te при 298° К. Уточнены и приведены характеристики фазовых диаграмм $Tl-S$, $Tl-Se$ и $Tl-Te$. Обобщены данные по теплотам образования халькогенидов Ga, Tl и In. Отмечена линейная зависимость между полусуммой кратчайших межатомных расстояний в решетках чистых компонентов

 (δH_f) (+)

X 1976 N 9

составляющих халькогенидные фазы, $x=0,5$ ($d_{M-M} + d_{X-X}$) и приведенным значениям теплоты образования $y = \Delta H(\text{обр.})/T_m$ в точке плавления T_m . Для соединений типа MX , M_2X и M_2X_3 установлены зависимости $y = -42,50 + 10,70x$, $-29,27 + 6,66x$ и $-38,36 + 9,52x$ кал/г-ат·град. с коэф. корреляции $r = 0,92$, $0,89$ и $0,96$ соотв. Из корреляц. ур-ния вычислена энталпия образования In_2Se $\Delta H(\text{обр.}) = -8,7$ ккал/г-ат ($T_m = 813 \pm 10^\circ\text{K}$). Отмечено, что теплоты образования халькогенидов алюминия типа Al_2X_3 не укладываются в соотв-щее корреляц. уравнение.

А. Гузей

Tl₂Se

1975

23 Б503. Кристаллическая структура сульфида таллия, Tl_2S_5 . Leclerc B., Kabte T. S. Structure cristalline du sulfure de thallium Tl_2S_5 . «Acta crystallogr.», 1975, B31, № 6, 1675—1677 (франц.; рез. англ.)

Проведено рентгеноструктурное исследование (метод Вейсенберга, λ Mo, 329 отражений, МНК в анизотропном приближении до $R=0,072$) Tl_2S_5 . Параметры ромбич. решетки: a 6,660, b 16,70, c 6,538 Å, ρ (изм.) 5,18, ρ (выч.) 5,20, $Z=4$, ф. гр. $P\bar{2}_12_12_1$. Пять кристаллографически независимых атомов S в структуре образуют изолированные цепочки-ионы лентасульфида S_5^{2-} , связь между ячейками осуществляется ионами Tl. Длины связей S—S в цепочке 2,06—2,16 Å, углы SSS 107,6—108,8°. Атомы Tl располагаются относительно центрального атома S цепочки на расстояниях не менее 3,57 Å, тогда как концевые атомы S цепочки окружены атомами Tl на расстояниях 3,04—3,37 Å, что согласуется с предположением о локализации отриц. заряда иона S_5^{2-} на концевых атомах S. Пирамидальная координация атомов Tl может быть дополнена до тетраэдрич. стереохимически активной неподеленной парой $6s^2$ моновалентного иона Tl.

И. В. Булгаровская

X 1975 № 23

1975

Tl_xSeBixSeSbxSe ΔH_{mix} ΔS_{mix}

+2



137874w Thermodynamic properties of liquid thallium-selenium, bismuth-selenium, and antimony-selenium alloys.

Predel, Bruno; Piehl, Juergen; Pool, Monte J. (Inst. Metallkd., Univ. Stuttgart, Stuttgart, Ger.); *Z. Metallkd.* 1975, 66(7), 388-95 (Ger). As a contribution to the clarification of the relation between energetic properties and the at. structure of liq. alloys, thermodyn. activities were detd. in the systems thallium-selenium, bismuth-selenium and antimony-selenium. The calcd. excess integral free enthalpies suggest the existance of concn. fluctuations with the compns. TlSe [12039-52-0], Bi₂Se₃ [12068-69-8] and Sb₂Se₃ [1315-05-5] resp. in the liq. alloys considered. In addition, integral mixing enthalpies for the liq. alloys in the thallium-selenium system were measured calorimetrically. Their concn. dependence and that of the mixing entropies obtained from the free mixing enthalpies and the mixing enthalpies likewise suggest strong deviations from a statistical at. distribution with a preference for TlSe concn. fluctuations. An anal. of the $\Delta H-x$ curve shows that the Tl-Se melt is nearly completely assortd. at $x = 0.5$.

C.H. 1975

83

N/16

1975

Tl₂Se

GaSe

In₂Se

C_p, H-H,

S_T, ΔG

Character ...

161005p Equations for calculating the temperature dependence of thermodynamic properties of some semiconductors. Rymkevich, P. P.; Maslov, P. G.; Zaitsev, N. M.; Hoang Van Pao; Vu Xuan Ban (USSR). *Zh. Prikl. Khim. (Leningrad)* 1975, 48(1), 209-10 (Russ). Equations for calcg. heat capacity C_p , enthalpy $(H - H_0)T^{-1}$, entropy S_T and free energy dependence on temp. for a no. of semiconductors are proposed. The calcd. and exptl. determined thermodynamical properties of TlSe [12039-52-0], InSe [1312-42-1] and GaSe [12024-11-2] are consistent with accuracy of 0.1-2%.

K. Plochocka

+1

C.A. 1975, 82 v 24

(see. InSe, I)

1975

TlSe, Tl₂Se

) 137679m Determination of the thallium-selenium phase diagram in the range of 33.3 to 75 atomic percent selenium by means of differential scanning calorimetry (DSC). Tausend, A.; Wobig, D. (Inst. Festkoerperphys., Tech. Univ. Berlin, Berlin, Ger.). *Z. Phys. Chem. (Frankfurt am Main)* 1975, 96(4-6), 199-214 (Eng). DSC cooling and heating curves of a simple binary system are calcd. and compared with measured traces of the Tl-Se phase diagram in the range of 33.3 to 75 at.% Se. The eutectic temps. of the Th rich and the Se rich eutectic are 315 and 202°, resp., at 43 and 74 at.% Se. The m.ps. of the stable compds. TlSe and Tl₂Se are 344 and 390°, the heats of fusion are 4.83 and 3.63 kcal/mole, resp. The γ-phase reported by Vasil'ev et al. (1971) is confirmed. The results of these measurements are in agreement with former x-ray investigations.

C.A. 1975. 83 N/6

PlaSe

XV-3384

1976

(LHui,
GMM)

Беденкач cl. B, ugg.

47. Золот. Азепс. 9к-т.
(лп. ХЛиц. Н. 1976, и. 1,

31-3.

ГМ

[Call PlaSe] I

Tl₂Se

Кириев ф. ф.

1976

"Агрд. хим. м."

1976, № 2, 113-114 (рас. агрд.)

(ΔH_m)

(если Ga₂Se; I)



1977

 Tl_2Se Tl_2Te диагр.
изделия (T_m)

(+) ⚡



5 Б773. Фазовое равновесие в системе Tl_2Se-Tl_2Te .
 Асадов М. М., Бабаилы М. Б., Кулев А. А.
 «Азэрб. жимја ж., Азерб. хим. ж.», 1977, № 2, 94—96
 (рез. азерб.)

Методами ДТА, рентгенофазового анализа, а также измерениями микротвердости изучено фазовое равновесие в системе Tl_2Se (I)— Tl_2Te (II). Т. пл. исходных I и II равны 390 и 425° соотв. Полученные синтезом образцы отжигали в течение 400 часов. Представлена диаграмма плавкости системы, к-рая относится к эвтектич. типу (~20 мол. % II и т. пл. 375°), в ней образуется широкая область тв. р-ров на основе I и II. Микротвердость тв. р-ров на основе I растет с изменением состава более резко, чем микротвердость тв. р-ров на основе II. Приведена зависимость межплоскостного расстояния от состава тв. раствора. Л. Г. Титов

2, N5, 1978

1974

Tl₂Se

Tl₂Se (Tb)

Bauer J, et al

V. II, p. 965

298-663

298-607

coll. AGF.-I

71229.342

42530

1977

Ph, Ch, MGU

TlSe₂ XV-3733

Dupree R., Warren W. W., Jr.,
Di Salvo F.J., Jr. ⁷⁷Se NMR study of the
electronic instability in TiSe₂. "Phys.
Rev. B: Solid State", 1977, 16, № 3, 1001-
1007.

(англ.)

0012 11.11

974 980

ВИНИТИ

1978

Исследование фазового равновесия в системе Tl_2Se-Ag_2Se . Абишов В. Т., Бабанлы А. Б., Кулиев А. А. «Елми әсәрләр. Азәрб. унив. Қимја елмләри сер., Уч. зап. Азерб. ун-т. Сер. хим. н.», 1978, № 4, 50—52

С помощью ДТА, рентгенофазового анализа и измерений микротвердости изучены фазовые равновесия в системе Tl_2Se (I) — Ag_2Se (II). Исходные I и II синтезировали сплавлением в вакууме простых в-в при 500—600° (Tl, Ag — 99,99; Se — 99,9999% чистоты). Сплавы отжигали в течение 450 час. ниже т-ры солидуса. Представлена диаграмма состояния системы, в к-рой образуются три соединения: $AgTlSe$ (III) с т. пл. 390° (конгруэнтно), Ag_3TlSe_2 (IV) и Ag_7TlSe_4 с т. пл. 391 и 425° соотв. (оба инконгруэнтно). Перитектич. точки находятся при 70 и 80 мол. % II. III образует эвтектики с I при 18 мол. % II с т. пл. 315°, и с IV при 68 мол. % II с т. пл. 382°. Данные по микротвердости сплавов согласуются с диаграммой состояния.

Л. Г. Титов

Tl_2Se
 Ag_2Se

разнов
равнов.

(t₁) 8

x, 1979, N15

1978

 Tl_2Se Ag_2Se

91: 199657b Study of phase equilibrium in the thallium selenide (Tl_2Se)-silver selenide (Ag_2Se) system. Abishov, V. T.; Babanly, A. B.; Kuliev, A. A. (USSR). *Uch. Zap. Azerb. Un-t. Ser. Khim. N.* 1978, (4), 50-2 (Russ). From Ref. *Zh., Khim.* 1979, Abstr. No. 15B800. Title only translated.

газобое

габробое

(+) 

P.A.1979.Q1.n24

TlSe

1978

90: 142719y Determination of the thallium-selenium phase diagram in the range from 73 to 100 atomic percent selenium. Braetter, P.; Busse, H.; Scheiba, M.; Wobig, D. (Nucl. Chem. Div., Hahn-Meitner-Inst., Berlin, Ger.). *Z. Phys. Chem. (Wiesbaden)* 1978, 110(1), 29-50 (Eng). The phase diagram of the system Tl-Se, in the compn, limits of 73-100 at.% Se, was detd. by differential scanning calorimetry (DSC), flameless at. absorption spectroscopy (AAS), and x-ray structure anal. X-ray studies were performed at elevated temps. and by using the high temp. camera developed by Seeman. The main features of the diagram are: (1) The eutectic is formed at 202°, the eutectic compn. is 73.6 at.% Se, the solidified material below 202° consists of TlSe and Se; (2) The miscibility gap in the liq. region ranges from 23.7 at.% Tl to 225 ppm Tl at the monotectic temp. 220°. The crit. soln. temp. and the crit. exponent are 456.5 and 0.348, resp. The phase Tl_2Se_3 , which was reported by other investigators, was not obsd. in this work.

pazob
guaraf.

C.A 1979, 90, N18

TlSe

XVII-3700

*Кристал.
структур*

х. 1979 № 3

3 Б543. Особенности кристаллической структуры и роста кристаллов TlSe. Гусейнов Г. Д., Гусейнов Г. Г., Исмайлова М. З., Керимова Э. М., Рустамов В. Д., Раева Л. А. «АзССР Елмлэр Акад. хэбэрлэри Физ.-техн. вэријацијат елмлэри сер., Изв. АН АзССР. Сер. физ.-техн. и мат. н.», 1978, № 1, 47—53 (русск.; рез. англ.)

Описана структура TeSe (I) (ф. гр. $J4/mcm$, $a = 8,02$, $c = 7,00 \text{ \AA}$, $Z=8$), особенностью к-рой является испарное число валентных электронов, разная валентность однотипных катионов (Tl^+ и Tl^{3+}) и их структурная неэквивалентность (Tl^+ в 4 (a) участвуют в ионной связи, Tl^{3+} в 4 (b) образуют типичные для полупроводниковых соединений тетраэдрич. sp^3 -связи). ($\text{In}-\text{Se}$ 2,56, $\text{Se}-\text{Se}$ 3,9—4,5, $\text{Tl}-\text{Se}$ 3,42, $\text{Se}-\text{Se}$ 4,06 \AA).

Кристаллы I и II выращивались в откаченных (10^{-4} mm Hg) и запаянных кварцевых ампулах методом зонной плавки (длина зоны 5—15 мм, скорость ее перемещения 6—20 mm/час , число проходов 4—30). Кристаллы I и II раскалывались по двум взаимно перпендикулярным зеркальным плоскостям и приобретали форму прямоугольных параллелепипедов с продольными плоскостями (110). Ось с параллельна направлению перемещения зоны при горизонтальной зонной перекристаллизации и перпендикулярна — при вертикальной. При горизон-

тальной кристаллизации с малой скоростью (~ 5 мм/час) методом медленного охлаждения (~ 3 град/час) при постоянном т-рном градиенте (~ 5 град/см) ось с направлена по диам. слитка, а одна из названных плоскостей скальвания горизонтальна. Во всех случаях нормаль к одной из плоскостей скальвания параллельна силе тяжести, а нормаль к др. — направлению т-рного градиента. Получены эпитаксиальные пары I-II с зеркальной границей, весьма перспективные в связи с различием ширины запрещенных зон (0,5 эв для I и 1,2 эв для II). Наиболее технол. метод их получения — поверхн. сплавление кристаллов I и II, прижатых зеркальной гранью (110) в печи с вертикальным т-рым градиентом. При этом нижняя пластина II (т. пл. 810°)

служила затравкой для расплавленного I (т. пл. 320°), находящегося в высокот-рной зоне (400°), в процессе медленного охлаждения (~ 1 град/час) при постоянном перепаде температур.

С. Ш. Шильштейн

1973

TlSe

TlTe

(C_p)

(+)

2 Е304. Теплоемкость селенида и теллурида таллия при низких температурах. Мамедов К. К., Алджанов М. А., Керимов И. Г., Мехтиев М. И. «АзССР Елмлэр Акад. хэбэрлэри. Физ.-техн. вэријјат өлмлэри сер., Изв. АН АзССР. Сер. физ.-техн. и мат. н.», 1978, № 1, 71—73 (азерб., англ.)

В интервале t -р $2-4^{\circ}\text{K}$ исследована теплоемкость TlSe и TlTe. Проведено вычисление т-ры Дебая Θ этих соединений; Θ для TlTe лежит в интервале $80-100^{\circ}\text{K}$, для TlSe — $100-120^{\circ}\text{K}$. Температурный коэф. Θ положителен.

В. Е. Зиновьев

1973.6.2

TlSe

1978

TlTe

89: 153661d Heat capacity of thallium selenide and telluride at low temperatures. Mamedov, K. K.; Aldzhanov, M. A.; Kerimov, I. G.; Mekhtiev, M. I. (USSR). *Izv. Akad. Nauk Az. SSR, Ser. Fiz.-Tekh. Mat. Nauk* 1978, (1), 71-3 (Russ). The heat capacities were measured in an adiabatic calorimeter at 2-20 K, with estd. errors of 4% at 3 K and 0.3-1% above 5 K. The Debye temps. were caled. The Debye cubic law holds at 2-3.3 K for TlSe, at 2-3 K for TlTe.

C_p ; θ_D

☒

⊕



C.A. 1978, 89, N18

PLSe.

[X - 10312]

1978

Moodenbaegh H.R., Jonston D.C. et al.,

(T_{c2} , Φ) J. Low Temp. Phys.,
1978, 33, N 1-2,
175-203

1979

TlSe

GeSe₂

Tl₂GeSe₄

magob.

quartz.

✓ 92: 83357v Thallium selenide-germanium selenide (Tl=Se-GeSe₂) system. Turkina, E. Yu.; Kozhina, I. I.; Orlova, G. M. (Leningr. Gos. Univ., Leningrad, USSR). *Zh. Neorg. Khim.* 1979, 24(11), 3134-6 (Russ). The TlSe-GeSe₂ section of the Tl-Ge-Se system was studied by DTA, microstructural, and x-ray phase anal. The 2 compds. Tl₂GeSe₄ and TlGeSe₃ form peritectically at 324 and 440°, resp. Interplanar spacings are given for the ternary compds.

(2) ~~✓~~

CA 1980 92 n10

TlSe .

1980

Манегов К. С., и др.

Укр. гео. к., 1980, 39,
№, 1005-9.

(ρ) ($T_{\text{дис}}$)



cell. TlS-1

Tl₅-Se₃

1980

5 Б589. Электронографическое определение структуры тетрагональной фазы Tl₅Se₃. Ман Л. И., Пармон В. С., Имамов Р. М., Авилов А. С. «Кристаллография», 1980, 25, № 5, 1070—1072

Электронографически определена (метод косых текстур, 108 отражений, изотропное приближение, $R = 15,28\%$) структура тонких Пл Tl₅Se₃. Параметры тетрагон. решетки: $a = 8,54$, $c = 12,38$ Å, ф. гр. C_{4h}^3-P4/n . Атомы в структуре располагаются гофрированными слоями, параллельными плоскости (001); слой из атомов Se заключён между двумя слоями из атомов Tl, на элементарную ячейку приходится два таких пакета, между к-рыми располагаются смешанные слои из атомов Tl и Se (Tl—Se 2,81—3,38, Tl—Tl 3,20 Å). Отмечается сходство структуры Tl₅Se₃ со структурами соединений Tl₅Te₃ и In₅Bi₃.

С. В. Соболева



Х. 1981. № 5

TlSe

Omnicr 12622

1981

(C_p, Θ_D)

Aliev A.M., et al.,

Phys. Stat. Sol. 1981,
(8)107, K 151-K 154

Tl Se

1981

(pay. guard.)

'95: 157503a The thallium-selenium phase diagram and its relationship with glass formation. Morgant, G.; Legendre, B.; Maneglier-Lacordaire, S.; Souleau, C. (Univ. Paris-Sud, Unites Enseign. Rech., 92290 Chatenay-Malabry, Fr.). *Ann. Chim. (Paris)* 1981, 6(4), 315-26 (Fr). The equil. phase diagram is established by classical methods. A new cubic centered polymorphic form of TlSe is formed at high temp. (~200°). No evidence for the existence of Tl_2Se_3 was found. Glass formation conditions and crystn. temp. are detd. for 63-100 mol % Se.

A. J. Miller

C. A. 1981, 95, N18.

Se-Tl

Tl₂Se_x

1981

196: 130780x Thermodynamic data on thallium-selenium system at 738 K, 675 K and 655 K. Morgant, G.; Legendre, B.; Souleau, C.; Didry, J. R. (Lab. Chim. Miner. II, Univ. Paris-Sud XI, 92290 Chatenay-Malabry, Fr.). *Ann. Chim. (Paris)* 1981, 6(8), 661-70 (Fr). The integral and partial heats of alloying of Se-Tl melts were measured by drop calorimetry.

Melting point: Observations of jumps in the partial enthalpy vs. compn. curves confirm the phase boundary of this system. Existence of Tl₂Se mol. species in the liq. phase was confirmed.

C.A. 1982, 96, N 16

Tl₂Se

1981

1981: 41730e Enthalpy and entropy of melting of some thallium chalcogenides. Tkachenko, V. I.; Novikova, A. G.; Baran, L. P.; Semrad, E. E. (USSR). Deposited Doc. 1981, SPSTL 495 Khp-D81, 8 pp. (Russ). Avail. SPSTL. A Calvin microcalorimeter was used to measure the heats and entropies of fusion of Tl₂S [1314-97-2], Tl₂Se [15572-25-5], and Tl₂Te [12040-13-0]. Details of the exptl. installation are given.

Δm H,

Δm S;

(42) A7

C.A. 1983, 98, N6.

[Tl Se]

1982

Тепловое расширение

11 Б608. Тепловое расширение TlS/e. Курбаков М. М., Годжаев Э. М., Гулиев Л. А., Нагиев А. Б. «Физ. тверд. тела», 1982, 24, № 1, 274—276

X. 1982, 19, N 11.

1982

TlSe

7 Е271. Тепловое расширение TlSe. Курбанинов М. М., Годжаев Э. М., Гулиев Л. А., Нагиев А. Б. «Физ. тверд. тела», 1982, 24, № 1, 274—276

В интервале т-р 78—370 К на кварцевом дилатометре измерено тепловое расширение поликристаллич. образца TlSe. Относительная погрешность измерений составляла 0,5 %. Коэф. линейного расширения (КЛР) увеличивается с т-рой, затем при т-ре выше ~200 К степень температурной зависимости постепенно уменьшается, а начиная с 250 К КЛР почти не зависит от т-ры. Значения КЛР, коэф. изотермич. сжимаемости и разности теплоемкостей $C_p - C_v$, вычисленных по термодинамич. соотношению и эмпирич. ф-ле Нернста—Линдемана приведены в таблице. Вычисленный параметр Грюнайзена для TlSe в интервале т-р 170—300 К почти остается постоянным и примерно равен 0,4.

Я. П.

тепловое
расширение

φ. 1982, 18, N 7.

Tl₂Se

ОМ. 15288

1982

Д 6 Б875. Молярные теплоемкости соединений TlSe и Tl₂Se в твердом и жидким состоянии. Capacités calorifiques molaires des composés TlSe et Tl₂Se dans les états solide et liquide. Morgant G., Legendre B., Souleau C. «Ann. chim.» (France), 1982, 7, № 4, 301—308 (фр.; рез. англ.)

Теплоемкость C_p соединений TlSe (I) и Tl₂Se (II) измерена методом смешения с использованием калориметра Кальве в интервале 336—775К для I и 336—825 К для II. Приведены аналитические выражения теплосодержания в Дж/моль: $H_T - H_{298} \alpha - I = 50312$ ($T - 298$) (298 T 472 K); $H_{298} - H_T \beta - I = 8920 + 51,513$ ($T - 472$) (472—619 K), $H_T - H_{298}$ I, жидк. = $38689 + 78,761$ ($T - 619$) (619—775 K), $T_{пл.} = 619$ K, $\Delta H_{пл.} = 22,19 \pm 0,20$ кДж/моль, $\Delta S_{пл.} = 35,85$ Дж/К моль. Для II $H_T - H_{298} = 80,585$ ($T - 298$), т. пл. II = 659 K, $\Delta H_{пл.} = 16,95$ кДж/моль, $\Delta S_{пл.} = 25,72$ Дж/К моль, $H_T - H_{298}$ II, жидк. = $-509136,80 + 85532,5 \lg T$ (659—825 K). Проведено сравнение с лит. данными и с диаграммой состояния системы Tl—Se.

Л. А. Резницкий

Х. 1983, 19, N 6

Tl₂Se

Tl₂Se

Ommenck 15288 1982

97: 224239a Molar heat capacities of thallium(II) selenide and thallium(I) selenide in the solid and liquid states. Morgant, G.; Legendre, B.; Souleau, C. (Lab. Math., Univ. Paris Sud, 92290 Chatenay-Malabry, Fr.). Ann. Chim. (Paris) 1982, 7(4), 301-8 (Fr). The enthalpies of TlSe [12039-52-0] at 298-775 K and of Tl₂Se [15572-25-5] at 298-825 K were measured calorimetrically. The heats and entropies of fusion,

H_T-H_I,

ΔmH, ΔmS,

C_p;

c.A.1982, 97, N26

Tl₂Se

1982

19 Б735. Фазовые равновесия в системе Tl—Se при высоких давлениях. Понятовский Е. Г., Казанджан Б. И. «Изв. АН СССР. Неорганические материалы», 1982, 18, № 5, 745—751

С целью выяснения характера фазовых равновесий в системе Tl—Se при высоких давл. проведен ДТА сплавов этой системы в диапазоне конц-ий от 30 до 74 ат.% Se и в диапазоне давл. от 0,1 до 1,5 ГПа. Показано, что особенности эволюции Т—С диаграммы системы определяются наибольшей чувствительностью к давлению т. пл. сплавов вблизи фазы Tl₅Se₃, имеющей широкую область гомогенности. При $P \geq 0,15 - 0,2$ ГПа фаза Tl₂Se начинает плавиться инконгруэнтно, а при $P > 1,7$ ГПа инконгруэнтно плавится и фаза TlSe. В системе обнаружено два новых полиморфных превращения: $\gamma \rightleftharpoons \delta$ -Tl₂Se и $\varepsilon \rightleftharpoons \eta$ -Tl₅Se₃. Автореферат

T_{c2}, T_m

X. 1982, 19, N 19

Tl_2Se

Tl_5Se_3

описание
реакции

1982

197: 12607u Phase equilibrium in the thallium-selenium system at high pressures. Ponyatovskii, E. G.; Kazandzhan, B. I. (Inst. Fiz. Tverd. Tela, Chernogolovka, USSR). *Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater.* 1982, 18(5), 745-51 (Russ.). DTA studies at high pressure showed that Tl_2Se melts incongruently as pressure increases. The polymorphic transition $\gamma-Tl_2Se = \delta-Tl_2Se$ with very small heat and vol. effects was obsd. The phase Tl_5Se_3 exists with a wide homogeneity range and very high sensitivity of m.p. to pressure (166 K/GPa), undergoing the $\epsilon = \eta$ polymorphic transition at temps. which decrease abruptly as pressure increases (280 K/GPa). At high pressures, the evolution of the temp.-compn. phase diagram is detd. by the extensive region of Tl_5Se_3 (congruently melting).

C.A. 1982, 97, N2.

Tl_2Se

$TlSe$

1983

1983: 222772r Refinement of the fusibility diagram of the thal=lium-selenium system. Turkina, E. Yu.; Orlova, G. M. (Leningr. Gos. Univ., Leningrad, USSR). *Zh. Neorg. Khim.* 1983, 28(5), 1351-3 (Russ). DTA, microstructural, and x-ray phase anal. of the 33.33-100 at.% Se system confirmed formation of Tl_2Se and $TlSe$ (congruently m. 388, 340°, resp.). The compd. Tl_2Se_3 was not obstd. Alloys contg >78 at.% Se exhibit a monotectic region of 213°.

(Tm)

c. A. 1983, 98, N26

Tl_2Se

$TlSe$

1983

17 Б913. Уточнение диаграммы плавкости системы Tl—Se. Туркина Е.Ю., Орлова Г.М. «Ж. неорган. химии», 1983, 28, № 5, 1351—1353

Методами ДТА, рентгенофазового и микроструктурного анализов изучено взаимодействие компонентов системы Tl—Se в области конц-ий 33,33—100 ат.% Se. Подтверждено образование соединений Tl_2Se и $TlSe$ с траами конгруэнтного плавления 388 и 340°C соотв. Соединения Tl_2Se_3 не найдено. Сплавы с содержанием селена выше 78 ат.% расслаиваются, т-ра монотектич. реакции 213°C .

Резюме

X. 1983, 19, N 17

TlSe

1986

3 Б2248. Тепловое расширение TlSe и оптические свойства вблизи края фундаментального поглощения. Абдуллаев Н. А., Алиева Л. Н., Беленький Г. Л., Низаметдинова М. А., Сулейманов Р. А. «Физ. и техн. полупровод.», 1986, 20, № 9, 1703—1706

При т-рах 20—200 К исследованы т-ные зависимости коэф. линейного расширения для монокристаллов TlSe (I) в 2 направлениях, параллельной α_{\parallel} и перпендикулярном α_{\perp} цепочкам. Коэф. α положительны во всем исследованном интервале т-р, их величины монотонно растут с ростом т-ры, достигая значений $\alpha_{\perp} = 30 \cdot 10^{-6}$ и $\alpha_{\parallel} = 14 \cdot 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ при 150 К. Исследованы также спектры поглощения I при различных т-рах в поляризации света $E \parallel c$. Показано, что сжатие кристаллов I вдоль направления, перпендикулярного цепочкам, приводит к сдвигу края поглощения в сторону мень-

тепловое
расшир.

X. 1987, 19, № 3.

ших энергий. Считают, что рост ширины прямой запрещенной зоны TiSe с ростом т-ры обусловлен деформацией крист. решетки при тепловом расширении. Полученный результат свидетельствует о необходимости определения вклада теплового расширения в изменение E_g с т-рой при обнаружении в слоистых или цепочечных кристаллах аномалий в поведении ширины запрещенной зоны с температурой.

Л. А. Д.

TLSe

1986

2 Е310. Тепловое расширение TiSe и оптические свойства вблизи края фундаментального поглощения. Абдуллаев Н. А., Алиева Л. Н., Беленский Г. Л., Низаметдинова М. А., Сулейманов Р. А. «Физ. и техн. полупровод.», 1986, 20, № 9, 1703—1705

Обнаружение ранее в слоистых кристаллах отрицательное значение коэф. линейного теплового расширения параллельно слоям было интерпретировано в рамках теории И. М. Лифшица, согласно которой при низких т-рах тепловые свойства сильно анизотропных кристаллов определяются волнами «изгиба» — колебаниями, распространяющимися в направлении сильной связи и поляризованными в направлении слабой. Однако, в слабо анизотропном цепочечном или слоистом кристалле колебания изгибного типа не будут оказывать заметного влияния на термодинамич. свойства. Здесь показано, что рост ширины запрещенной зоны TiSe с ростом т-ры обусловлен простой деформацией кристаллич. решетки при тепловом расширении. В. К. Баженов

cf. 1987, 18, № 2

TlSe

1988

Demishov G. B., Kabalkina S. S., et al.

T_{tr} ;

Phys. status solidi. A.
1988. 108, N1, C. 89-95.

(see TlS ; I)

Tl₂Se

1988

Tl₂Se

Klamedov K. K.,
Yangirov A. Yu., et al.

МЕМО-
ЕДНОСИГ

"

СПОЛЮБ.

НПЕГПАУС.

Phys. status solidi,
1988, 106, № 2, 315-331.

(cell.  GaS; I)

Плз
Плз
Плз
Плз

Бобаков М.Р.,
Юсубов Ю.А. и др.
(Тезисы докладов).

1989

IV Всесоюзная Конференция.
Периодикаль и материко-
вещественные полупроводники,
г. II, Москва, 1989, стр. 327.

Плз

1989

1 Б2427. Получение и электрические свойства моно-
кристаллов селенида таллия. On the preparation and
electrical properties of thallium selenide monocrystals /
Hussein S. A., Nagat A. T. // Cryst. Res. and Technol.—
1989.— 24, № 3.— С. 283—289.— Англ.

Модифицированным методом Бриджмена из распла-
ва выращены монокристаллы TlSe (I). Методом рент-
генографии найдено, что I имеет тетрагон. структуру с
ф. гр. D_{4h}^{18} и параметрами решетки a 8,025, c 7,01 Å.
При т-рах 150—450 К в вакууме для I изучены элек-
тропроводность (σ_{\parallel} , σ_{\perp}) и коэффициенты Холла ($R_{n\parallel}$,
 $R_{n\perp}$) вдоль и поперек кристаллографич. оси c . Найде-
но, что I является анизотропным полупроводником p -
типа с шириной запрещенной зоны $\sim 0,69$ эВ. Энергия
ионизации акцепторов в I составляет 0,21 эВ. Конц-ии
и подвижности носителей при комн. т-ре в I равны
соотв. $p_{\parallel}=3,16 \cdot 10^{13}$, $p_{\perp}=4,57 \cdot 10^{16}$ см $^{-3}$ и $\mu_{n\parallel}=112,2$,
 $\mu_{n\perp}=42,66$ см $^2 \cdot В^{-1}с^{-1}$. Значения σ_{\parallel} и σ_{\perp} при этом
составляют соотв. $8,7 \cdot 10^{-4}$ и $164 \cdot 10^{-4}$ Ом $^{-1} \cdot см^{-1}$. От-
мечено, что фактор анизотропии $K=\sigma_{\perp}/\sigma_{\parallel}$ для I экспоненциально растет с понижением температуры.

В. В. Волков

получил и
электр. св-ва

Х. 1990, № 1

Техн

1990

10 E636. Структура бинарной кристаллической халькогенидной системы Tl—Se. The structure of the binary chalcogenide crystalline Tl—Se system / Kotkata M. F., Radwan M. M., Abdel-Rahman A. M. // Acta phys. hung.— 1990.— 68, № 3—4.— С. 149—158.— Англ.

Методом рентгеновской дифрактометрии изучена система Tl_xSe_{1-x} , причем $0,0 \leq x \leq 0,9$. Обнаружено существование четырех кристаллич. фаз. При $0,0 \leq x \leq 0,4$ существует гексагональный кристаллич. селен. При больших значениях величины x образуются стекла Se—Tl. Тетрагональная кристаллич. фаза $SeTl$ существует при $0,005 \leq x \leq 0,9$, а тетрагональная фаза $SeTl_2$ — при $0,58 \leq x \leq 0,9$. Гексагональная фаза α -таллия наблюдается при $0,7 \leq x \leq 0,9$. Описано влияние содержания таллия на межплоскостные расстояния (d_{hkl}) и относительные интенсивности (I/I_0) дифракционных линий Se.

Е. С. А.(

phi. 1991, N 10

PLSe

(OM-36410)

1992

Курбамов М.М.,

(p, χ) Медаль. мастер. 1992,
28, №2, 309-311.

Пелех

1993

5 Б2173. Низкотемпературная электропроводность нитевидных кристаллов твердого раствора Te—Se /Вайнберг В. В., Варшава С. С., Пелех Л. Н. //Укр. физ. ж. —1993.—38, № 12.—С. 1830—1836.—Рус. ;рез. укр., англ.

Исследованы т-рные зависимости уд. сопротивления ρ и коэф. Холла R_H в широком диапазоне низких т-р $T=300 \div 1,5$ К, а также поперечное и продольное магнитосопротивление (МС) при $T \leq 4,2$ К для ряда нитевидных кристаллов (НК) тв. раствора Te—Se с атомным содержанием Se от 0 до 2,3%. Зависимость $\rho(T)$ имеют минимум при $T=20 \div 40$ К и описываются законом $\rho=a-b\lg T$ при $T < T_{min}$. Абс. величина ρ и наклон зависимости $\rho(T)$ на участке $\rho \sim -\lg T$ немонотонно зависят от содержания Se. Поперечное МС исследованных образцов во всем диапазоне магнитных полей и для всех значений

Желтую
верстку

X. 1995, N 5

содержания Se положительно и имеет квадратичный и линейный по полю участки. Продольное МС в отличие от поперечного в области полей ($0 \div 0.6$ Тл) имеет участок небольшого отриц. МС. Наблюдаемые особенности $\rho(T)$ и МС обсуждаются в рамках модели, учитывающей проявление эффекта Кондо в низкот-рной проводимости.

Tl₂Se

1994

2 Б2271. Структура жидкого селенида таллия. The structure of liquid thallium selenide :[Pap.] Eur. Phys. Soc. 2nd Liquid Matter Conf., Florence, 18—22 Sept., 1993 /Barnes A. C., Guo C. //J. Phys.: Condens Matter. —1994.—№ 6 ,Suppl. 23A .—С. A229—A234 .—Англ.

С использованием методов дифракции нейтронов и изотопного замещения исследована структура жидк. полупроводникового селенида таллия Tl₂Se и определены его парц. структурные факторы. Показано, что структура жидк. Tl₂Se согласуется со структурой системы, к-рая в основном определяется ионными вз-виями. Получено хорошее качеств. согласие с парц. структурными факторами, ранее определенными для Tl₂Te в среднесферич. приближении.

В. Ф. Байбуз

Структура

X. 1995, № 2

Tl₂Se

1997

128: 299954x A torsion-effusion study of the sublimation of Tl₂Se. Brunetti, Bruno; Guido, Marcella; Piacente, Vincenzo (Dipartimento di Chimica, Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", 00185 Rome, Italy). *High Temp. Mater. Sci.* 1997, 37(3), 159-166 (Eng), Humana Press Inc.. The vaporization of Tl₂Se was studied by the torsion method. The temp. dependence of the vapor pressure of this compd. in the range 838-990 K is expressed by the equation: $\log[p(\text{kPa})] = (7.78 \pm 0.27) - (9394 \pm 260)/[T(\text{K})]$. By second- and third-law treatment of the pressure data, the selection sublimation enthalpy $\Delta_{\text{vap}}H^\circ(298) = 218 \pm 4 \text{ kJ/mol}$ was derived.

Linda
Moffat

Moffat

O.H. Meng

P.J.B.V.H.

CA-1998, 128, N24